

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏

幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也・諸岡 哲

日時 11月 9日 (木) 10:00~16:40

10日 (金) 10:00~16:40

会場 機械振興会館 6F 66号室 (港区芝公園 3-5-8. 東京メトロ日比谷線; 神谷町駅下車, 徒歩 8分. <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>)

議題 プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

9日午前

1. [招待講演] GaN MOVPE 成長のマルチフィジックスシミュレーション ○白石賢二・関口一樹・長川健大・白川裕規・川上賢人・山本芳裕・洗平昌晃・芳松克則 (名大)・寒川義裕・柿本浩一 (九大)
2. [招待講演] SISPAD 2017 レビュー(1) 廣木 彰 (京都工繊大)

9日午後 (13:05~)

3. p-LDMOSFET のホットキャリア耐性を向上させる新構造の検討  
○酒井 敦・永久克己・藤井宏基・森 隆弘・秋山 豊・山口泰男 (ルネサス エレクトロニクス)
4. [招待講演] SiC 中の不純物拡散モデル 植松真司 (慶大)
5. [招待講演] SiC パワー MOSFET の特性測定とモデル化  
○佐藤高史・大石一輝・廣本正之 (京大)・新谷道広 (奈良先端大)
6. [招待講演] 深いトラップを含む GaN MOS キャパシタ容量のシミュレーション  
○福田浩一・浅井栄大・服部淳一・清水三聡 (産総研)・橋詰 保 (北大)

10日午前

1. [招待講演] SISPAD 2017 レビュー(2) 来栖貴史 (東芝メモリ)
2. [招待講演] 不純物の離散性に伴った半導体デバイスモデリングの基本的側面—ランダム不純物ばらつきと自己平均化— 佐野伸行 (筑波大)

10日午後 (13:30~)

3. [招待講演] 極微細トランジスタの量子輸送シミュレーション  
○森 伸也・美里劫夏南 (阪大)・岩田潤一・押山 淳 (東大)
4. [招待講演] 行列指数法によるデバイス過渡シミュレーションの正確な時間刻み指標  
○熊代成孝・亀井達也・廣木 彰・小林和淑 (京都工繊大)
5. [招待講演] トラップ電荷起因抵抗を考慮した 28 nm 世代混載フラッシュ向け SG-MONOS SPICE モデル  
○黄 俐昭・宮森 充・常野克己・牟田哲也・川嶋祥之 (ルネサス エレクトロニクス)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

12月 22日 (金) 京大 [締切済] テーマ: Si, Si を含む材料の作製, プロセス技術, デバイス, 及びディスプレイ  
関連技術

【問合先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp